

# Background simulation of a low background gamma ray spectrometer with an array of five germanium detectors







#### 1. 研究背景和任务

#### 2. GeTHU-IV的能谱分解与氢本底分析

#### 3. ARGUS的蒙卡模拟

#### 4. 总结与展望

### 1研究背景



#### 暗物质探测、无中微子双贝塔衰变等极低本底稀有事例探测实验

- 降低**宇宙射线本底**——地下实验室
- 降低**环境辐射本底**——复合屏蔽系统
- 降低实验装置自身本底——材料筛选和本底控制



国际上主要地下实验室分布





### 1研究背景 Cu的材料放射性有多低? <1µBq/kg!



#### 暗物质探测、无中微子双贝塔衰变等极低本底<mark>稀有事例探测实验</mark>

- 降低宇宙射线本底——地下实验室
- 降低环境辐射本底——复合屏蔽系统
- 降低**实验装置自身本底**——材料筛选和本底控制

0vββ实验组	材料	$^{232}$ Th( $\mu$ Bq/kg)	$^{238}$ U( $\mu$ Bq/kg)	$^{40}$ K( $\mu$ Bq/kg)
	铜支架	<19	<15	-
GERDA <sup>228</sup> Th <b>⊼</b> ∏ <sup>226</sup> Ra	硅支架	<10-3	<10-4	$4.3 \times 10^{3}$
	聚四氟乙烯	30	25	600
	电解铜	<0.112	<0.119	-
MAJORANA	铅块	$5.297 \pm 5.297$	$36.076 \pm 24.88$	-
	聚四氟乙烯	20.78	94.54	-
	电缆	81±57	$107 \pm 45$	-
Lengend	电解铜	$0.70 \pm 0.32$	0.97±0.48	-
	溴苯	25±17	134±4	-
EXO 200	铜低温恒温器	<b>&lt;9.8</b>	<3.2	<12
EXO-200	铅屏蔽	<150	<50	<600

#### 怎么测量低放射性材料?

**电感耦合质谱 (ICP-MS) 气溶 胶、存在质谱干扰和基体效应** 电感耦合等离子体技术 (ICP) 和 质谱计数 (MS) 相结合

**中子活化分析 (NAA) 生成放射** 性核素本底、价格昂贵 用中子轰击样品,测定核反应瞬 发伽马射线或新放射性核素衰变

高纯锗探测器为主的γ射线光谱仪 测量周期长、需要极低本底环境 测量放射性核素衰变释放的γ射线 如果样品放射性低,MDA为上限





() 新華大学 Tsinghua University

────> 蒙卡模拟

 $L_{DZ}$ 表示在典型的能谱测量中能够以一定置信水平确定探测到某种放射性核素时其对应的衰变总数Z (服从高斯分布), MDA最小可探测活度表示在典型的能谱测量中能够以一定置信水平确定探测到 某种放射性核素时其应有的最小活度值。假设所有置信水平为1 –  $\alpha$  = 1 –  $\beta$  =95%, 本底涨落计数 率概率函数曲线分位值 $k_{\alpha}$ =1.645, 衰变总数概率函数曲线的分位值为 $k_{\beta}$ =1.645。

对于单个探头, 能谱净计数 $\hat{S} =$ 衰变总计数 $\hat{Z} \times 探测效率_{\mathcal{E}} = 能谱总计数<math>\hat{G} -$ 能谱本底计数 $\hat{B}$ 





1多探头MDA



#### 对于独立测量结果的净计数[ $\hat{x}_1 \cdots \hat{x}_n$ ],对应不确定度[ $\hat{\sigma}_1 \cdots \hat{\sigma}_n$ ] 蒙卡模拟

能谱净计数 $\hat{S}_i =$ 衰变总计数 $\hat{Z} \times 探测效率_{\epsilon_i} = 能谱总计数<math>\hat{G}_i -$ 能谱本底计数 $\hat{B}_i$ 

通过最大似然法来估计Z  $\widehat{x}_i \sim Gauss(u_i = Z \cdot \varepsilon_i, \sigma_i) \ \sigma_i^2 = S_i + 2B_i = Z \cdot \varepsilon_i + 2B_i \qquad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$  $P(Z|\hat{x_1} \cdots \cdot \hat{x_n}) = \frac{exp\left(-\sum \frac{(x_i - Z \cdot \varepsilon_i)^2}{2\sigma_i^2}\right)}{2\pi^{n/2} \prod \sigma_i}$  $\frac{\partial P(Z|\hat{x_1}\cdots\hat{x_n})}{\partial Z} = 0 \qquad \sum \frac{(\hat{x_i} - Z \cdot \varepsilon_i) \cdot \varepsilon_i}{\sigma^2} = 0$  $L_{DZ} = k_{\alpha}\sigma_{\hat{z}=0} + k_{\beta}\sigma\sigma_{\hat{z}=L_{DZ}}, \quad MDA = \frac{L_{DZ}}{m \times t \times L}$ 解方程估计Z后求解 $\sigma_{p}^{2}$ 

1 MDA公式应用于两组数据

考虑2个探头,探测效率 $\epsilon_1 \ln \epsilon_2$ ,本底为 $B_1 \ln B_2$ ,衰变总计数Z

能谱净计数 $\hat{S}_i =$ 衰变总计数 $\hat{Z} \times$ 探测效率 $\varepsilon_i =$ 能谱总计数 $\hat{G}_i -$ 能谱本底计数 $\hat{B}_i$  $\frac{\partial P(Z|\hat{x}_1, \hat{x}_2)}{\partial Z} = 0 \quad \frac{(\hat{x}_1 - Z \cdot \varepsilon_1) \cdot \varepsilon_1}{\sigma_1^2} + \frac{(\hat{x}_2 - Z \cdot \varepsilon_2) \cdot \varepsilon_2}{\sigma_2^2} = 0 \quad \sigma_i^2 = Z \cdot \varepsilon_2 + 2B_i$ 

$$\widehat{Z} = \frac{\sigma_1^2 \varepsilon_2 \widehat{x}_2 + \sigma_2^2 \varepsilon_1 \widehat{x}_1}{\sigma_2^2 \varepsilon_1^2 + \sigma_1^2 \varepsilon_2^2} = \frac{(Z\varepsilon_1 + 2B_1)\widehat{x}_2 \varepsilon_2 + (Z\varepsilon_2 + 2B_2)\widehat{x}_1 \varepsilon_1}{(Z\varepsilon_2 + 2B_2)\varepsilon_1^2 + (Z\varepsilon_1 + 2B_1)\varepsilon_2^2}$$

$$\sigma_{\widehat{Z}}^{2} = \frac{\sigma_{1}^{2}\sigma_{2}^{2}}{\sigma_{2}^{2}\varepsilon_{1}^{2} + \sigma_{1}^{2}\varepsilon_{2}^{2}} = \frac{(Z\varepsilon_{1} + 2B_{1})(Z\varepsilon_{2} + 2B_{2})}{(Z\varepsilon_{2} + 2B_{2})\varepsilon_{1}^{2} + (Z\varepsilon_{1} + 2B_{1})\varepsilon_{2}^{2}}$$

$$L_{DZ} = k_{\alpha} \sqrt{\frac{2B_1B_2}{B_2\varepsilon_1^2 + B_1\varepsilon_2^2} + k_{\beta}} \frac{(L_{DZ}\varepsilon_1 + 2B_1)(L_{DZ}\varepsilon_2 + 2B_2)}{(L_{DZ}\varepsilon_2 + 2B_2)\varepsilon_1^2 + (L_{DZ}\varepsilon_1 + 2B_1)\varepsilon_2^2}$$

如果取
$$B_2 = 0$$
  $\varepsilon_2 = 0$   $L_{DZ} = k_{\alpha} \sqrt{\frac{2B_1}{\varepsilon_1^2}} + k_{\beta} \sqrt{\frac{L_{DZ}\varepsilon_1 + 2B_1}{\varepsilon_1^2}}$  与直接推导单探头MDA公式相同

### 1研究背景 国际上高纯锗探测器性能



探测器	地点	Ge 质 量/kg	1332 keV 能量分辨 率/keV	想对探 测效率 /%	60-2700 keV 本底计数率 /kg/day
GeMPI		2.2	2.3	102%	$71 \pm 1^{a}$
GeMPI3	LNGS	2.2	2.2	98.70%	24±1ª
Gator		2.2	1.98	100.50%	89±0.7
Roseberry <sup>d</sup>		1	1.58	-	181.1
Belmont	BUGS	3.2	1.92	160.00%	135.0
Merrybent		2	1.87	100.00%	167.4
Maeve	BHUC	2	3.19	85.00%	956.1
Ge-14 <sup>e</sup>	HADES	2.57	~1.9	-	208±5
TU1	Felsenke ller	3.06	2	163%	116±1
Ge-III	Alabama	2.2	2.71	105.00%	8600
GeOroel	LSC	2.2	1.85	109.00%	165.3
GeMSE	LVdA	2	1.96	107.70%	82±1 <sup>b</sup>
GeTHU	CIDI	0.9	2.04	40%	905.7ª
GeTHU4	CJPL	2.48	~2	120%	211.4 <sup>b</sup>
OBELIX	LSM	3.2	~2	160.00%	74°
CAGe	Y2L	-	~2	70%	$90.4 \pm 0.3$

**晶体质量**普遍为2kg,约100%相对探测 效率,可大于3kg

<mark>分辨率</mark>1332keV为2keV附近

本底计数率普遍在100-200/kg/day区间, 部分能低于100/kg/day,最低为 24/kg/day (0.009cpkkd)

对应125kg铜样品测量100天 MDA<100µBq/kg

建造CJPL的低本底测量装置

a为40-2700keV b为100-2700keV c为30-3000keV d为BEGe探测器 e为SAGe小阳极锗

#### 2 CJPL-I的低本底伽马谱仪— —GeTHU

energy(keV)



2 GeTHU-IV的本底测量和数据处理

count rate(/kg/day)

本底主要来自于U、Th、<sup>40</sup>K、<sup>60</sup>Co、Rn experiment data fitting curve 能量刻度曲线 Energy(keV) 红色为填充铜前 本底大部分来自空腔内氡  $0.384 \pm 0.100$ CH  $\pm 1.037 \times 10^{-9}$ CH 500 Pb214 Pb214 Bi214 after filling Bi214 1120.3keV Pb212 295.2keV 1238.1keV 609.3keV 351.932keV 238.6keV 351.932keV 1377.7leV 5000 15000 10000 768.4keV 1764.5keV Channel 10 934.1keV before filling Ac228 Co60 Th 911.2keV 173.2keV K40 1588.2keV 1332.5keV T1208 4000 3000 3000 1460.8keV Κ U Τh 510.8ke Bi214 2500 T1208 2500 3000 2204.10keV 583.2ke 2614.511keV 2000 £ 2000 0 2000 8 1500 8 1500 1000 1000 1000 500 500 17.25 17.30 17.35 17.40 17.45 7.840 7.845 7.850 6.270 6.275 7.835 6.265 6.280 chi2 chi2 chi2 10 Co Rn Ge 6000 2000 4000 Rn 5000 Co 1500 3000 4000 -3000 0001 0 2000  $10^{-2}$ 2000 500 1000 1000 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 energy(keV) 3.856 3.858 3.860 3.862 3.864 3.866 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 2 4 6 1e-15 chi2 chi2 chi2 蓝色为填充铜后 实测本底能谱 使用拟合对实测谱能谱分解 填空腔本底降低至200cpkd 氡本底大幅度降低

Ge中宇生核素本底很低

I'singhua University

### 2 GeTHU-IV的氡本底分析

() Tsinghua University



### 2 GeTHU-IV的蒙卡模拟









#### 根据设计图纸构建模型 (是否填满铜分开模拟)











使用模拟谱检验能谱分解准确性

0.2 0.4

根据加工文件精准构建模型

### 2 GeTHU-IV氡浓度和MDA估算

能量(keV) 计数率 238.632 351.932 583.187 609.320 911.204 1460.80 60-27 (kg <sup>-1</sup> day <sup>-1</sup> ) 模拟谱 <sup>222</sup> Rn 20Bq/m <sup>3</sup> 1.187 12.364 0.420 11.798 0.237 0.219 225.3 实测谱 3.296 11.461 1.317 9.071 0.633 1.071 250.3 承注说明 Th可能 主要来 主要来 上要来 K-40可 能低估 222 22 能低估 MDA 238U 232Th 40K (609) (238) (1460) GeTHU-4德国铜屏蔽圆柱体 4.68 2.35 10.29 mBq/kg mBq/kg mBq/kg mBq/kg									
模拟谱222Rn 20Bq/m³1.18712.3640.42011.7980.2370.219225.3实测谱3.29611.4611.3179.0710.6331.071250.3審注说明Th可能 低估主要来 自Rn- 222主要来 自Rn- 222上K-40可 能低估MDA $2^{38}U$ (609) $2^{32}Th$ (238) $4^{0}K$ (1460)GeTHU-4德国铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)4.68 mBq/kg2.35 mBq/kg10.29 mBq/kg	能量( 计数 ( <b>kg</b> -1	keV) 枚率 day-1)	238.632	351.932	583.187	609.320	911.204	1460.80	60-2700
实测谱    3.296    11.461    1.317    9.071    0.633    1.071    250.33      备注说明    Th可能 低估    主要来 自Rn- 222    主要来 自Rn- 222    上要来 能低估    K-40可 能低估      MDA    238U (609)    232Th (238)    40K (1460)      GeTHU-4德国铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)    4.68 mBq/kg    2.35 mBq/kg    10.29 mBq/kg	模拟读 20B	<sup>É 222</sup> Rn q/m <sup>3</sup>	1.187	12.364	0.420	11.798	0.237	0.219	225.329
备注说明    Th可能 低估    主要来 自Rn- 222    主要来 自Rn- 222    K-40可 能低估      MDA    238U (609)    232Th (238)    40K (1460)      GeTHU-4德国铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)    4.68 mBq/kg    2.35 mBq/kg    10.29 mBq/kg      GeTHU-4普通铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)    15.76 mBq/kg    5.47 mBq/kg    10.51 mBq/kg	实测	则谱	3.296	11.461	1.317	9.071	0.633	1.071	250.125
MDA238U (609)232Th (238)40K (1460)GeTHU-4德国铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)4.68 mBq/kg2.35 mBq/kg10.29 mBq/kgGeTHU-4普通铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)15.76 mBq/kg5.47 mBq/kg10.51 mBq/kg	备注	说明	Th可能 低估	主要来 自Rn- 222		主要来 自Rn- 222		K-40可 能低估	
MDA238U (609)232Th (238)40K (1460)GeTHU-4德国铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)4.68 mBq/kg2.35 mBq/kg10.29 mBq/kgGeTHU-4普通铜屏蔽圆柱体 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day)15.76 mBq/kg5.47 mBq/kg10.51 mBq/kg									
GeTHU-4德国铜屏蔽圆柱体 4.68 2.35 10.29 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day) mBq/kg mBq/kg mBq/kg GeTHU-4普通铜屏蔽圆柱体 15.76 5.47 10.51 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day) mBq/kg mBq/kg mBq/kg			Μ	ÍDA		<sup>238</sup> U (609)	232 <b>]</b> (23	Th 2 8) (1	<sup>40</sup> K 460)
GeTHU-4普通铜屏蔽圆柱体 15.76 5.47 10.51 D=H=70mm(Cu 2.40kg 30day) mBq/kg mBq/kg mBq/kg		GeT D=H=	HU-4德国 =70mm(C	国铜屏蔽 Cu 2.40kg	圆柱体 ; 30day)	4.68 mBq/k	2.3 g mBq	5 10 /kg mI	0.29 3q/kg
		GeT D=H=	HU-4普通 =70mm(C	鱼铜屏蔽 Cu 2.40kg	圆柱体 ;30day)	15.76 mBq/k	5.4 g mBq	7 10 /kg mI	0.51 3q/kg

本底计数率: 氢浓度模拟参数为20Bq/m<sup>3</sup>时 模拟谱与实测谱较为接近,此时 超过90%的本底来自于氡 氢以外本底<20cpkd(100-2730keV)



### 2 mBq/kg量级谱仪模拟总结

Geant4蒙卡模拟 cern root数据处理



示意图一组4个探测器



低本底测量装置计划包含新建设15台mBq/kg量级谱仪

探测效率:改变样品形状、大小和材料

#### 本底水平:考虑锗宇生核素、探测器内元件、 铅铜屏蔽、氡本底(降低至0.1Bq/m<sup>3</sup>)等

样品	30天	<sup>238</sup> U	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K
	MDA(mBq/kg)	(609keV)	(238keV)	(1460keV)
Cu 圆柱体 D=H=70mm 2.40kg	冷却3年 <sup>222</sup> Rn=0.1Bq/m <sup>3</sup>	1.22	0.56	2.00

系统指标: MDA小于10.0 mBq/kg

俯视图 一组4个探测器

## 3 μBq/kg量级谱仪——ARGUS

只有mBq/kg的测量能力是不够的!电解铜活度已经可以小于1µBq/kg! 建立起一套µBq/kg量级辐射本底测量与分析装置ARGUS (a new ARray of GermaniUm γ-ray Spectrometer),和多套mBq/kg量级谱仪。 作为极低本底分析测试平台组成部分,放置在CJPL聚乙烯屏蔽仓内



ARGUS装置外观示意图

mBq/kg量级谱仪外观示意图

聚乙烯屏蔽仓放置位置

ARGUS

### 3ARGUS设计构思 增大探测效率,降低本底

5个P型同轴高纯锗探测器 4个为水平冷指 1个为U型冷指 屏蔽体形状均为正八边体,模拟结果选择普通铅(国标一号)15cm,低本底铅(进口老铅)5cm,剩余为高纯无氧铜(4N高纯铜)。









## 3 ARGUS的蒙卡模拟





探测器几何 1.场效应管FET及铜支架尺寸 2.冷指方向及冷指缝影响 3.Ge晶体空间位置及死层厚 度影响





样品几何 1.比较长方体、圆柱体样品 2.不同尺寸、质量、材料 3.不同样品中源项模拟



fsinghua University



复合屏蔽几何 1.不同材料组合 2.不同厚度和形状 3.内部空腔填满铜设计 4.不使用低本底铅的模拟 5.外部岩石混凝土本底模拟 17 3 探测器几何





3.1mm Ge Crystal Ø84×H84mm 30mm Cu Holder 45mm FET 20×20×2mm 10mm away from the center

### 部分模拟比较: Holder加厚处使用<mark>铜铅组合</mark> 低温恒温器使用Al还是Cu FET不同位置调研拟合

冷指设计优化及冷指缝模拟

0.014 0.012 0.01 0.004 0.002 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 能量 (keV) → 不考虑死层 → 考虑死层



探测器几何 1.场效应管FET及屏蔽 2.冷指方向及冷指缝影响 3.Ge晶体空间位置及死层 厚度影响

18

### 3样品几何





已模拟直径更 小的样品,效 率更低



样品几何 1.比较长方体、圆柱体、马林杯样品 2.不同尺寸、质量、材料 3.不同样品中源项模拟 4.样品腔的填充

单个探测器不同材料质量探测效率(D/H120mm)



马林杯放置示意图

D=220mm H=400mm 中挖孔 D=210mm H=300mm 中挖孔 D=114mm H=200mm 118.2kg D=114mm H=100mm 92.98kg



D=220mm H=300mm 中挖孔 D=280mm H=300mm 中挖孔 D=114mm H=200mm 84.5kg D=114mm H=200mm 147.4kg

### 3 屏蔽体几何





复合屏蔽几何 1.不同材料组合 2.不同厚度和形状 3.内部空腔填满铜设计 4.不使用低本底铅的模拟 5.外部岩石本底模拟



不同冷指设计下的屏蔽

- 形状模拟,包括圆柱、立方等,考虑材料用量、
  加工要求、屏蔽效果,选择八面体结构
- 屏蔽外部本底,单一材料铅厚度大约需要32cm, 铜厚度大约43cm,而聚乙烯厚度约350cm
- 多种复合结构比较
- 复合屏蔽为聚乙烯1m, 普通铅15cm, 低本底铅 5cm, 剩余为高纯无氧铜且最薄弱处至少15cm



单一屏蔽材料40-2700keV外部本底计数率

20





#### 源项为不同尺寸圆柱体或马林杯,使用不同材料样品,源项类型为不同能量gamma射线





3本底水平-源项设置



#### 对不同放射性活度模拟,按如下活度(mBq/kg),给出本底能谱结果

不同部件活度(mBq/kg)	238U	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	<sup>60</sup> Co	<sup>210</sup> Pb
铜屏蔽[1]	0.070	0.021	0.023	0.002	
低本底铅屏蔽[2]	1.2	0.41	0.31		6000
普通铅屏蔽[2]	1.2	0.41	0.31		100000
探测器铜外壳及支架[1]	0.070	0.021	0.023	0.002	
FET <sup>[3]</sup>	10.57	8.63	5.57		

### ROI取宽度为单边3 $\sigma$ , 能谱展宽选择实测能谱函数(来自原型机GeTHU-4)为 $\sigma = 0.02473 \times \sqrt{E} - 0.02319$

[1]E. Aprile, K. Arisaka, F. Arneodo, et al., Material screening and selection for XENON100. Astropart. Phys. 35, 43-49(2011).

[2]V. Alvarez, I. Bandac, A. Bettini, et al., Radiopu\_x0002\_rity control in the NEXT-100 double beta decay experiment: procedures and initial measurements. J. Instrum. 8, T01002(2013). [3]N. Abgrall, I.J. Arnquist, F. Avignone III, et al., The MAJORANA DEMONSTRATOR radioassay program.Nucl. Instrum. & Methods. Phys. Res. Sect. A 828, 22-36(2016).

3本底水平-宇生核素

对天然锗来说,因为Ge-68趋于饱和;区熔及晶体生长后,开始计算除Ge-68外的其它核素的产量。假设探测器无屏蔽制作90天、无屏蔽运输30天、地下冷却3年。

$$N(t) = \left(\frac{P}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda t}\right) + N_0 e^{-\lambda t}\right) e^{-\lambda T}$$

- P 所关注的天然锗宇生核素在海平面处的产生率,参考[1]
- t 受照时间, 共120天
- λ 对应宇生核素的衰变常数
- No 对应宇生核素初始核数,除Ge-68外为零
- **T** 地下冷却时间

#### 按冷却3年时间点,保守估计宇生核素本底



#### 地下实验室冷却3年Ge宇生核素本底模拟能谱

核素	<sup>68</sup> Ge	<sup>65</sup> Zn	<sup>60</sup> Co	<sup>57</sup> Co	<sup>55</sup> Fe	<sup>54</sup> Mn	<sup>49</sup> V
刚到达实验室活度(µBq/kg)	961.23	135.35	0.71	14.28	3.89	2.55	3.66
冷却3年活度(µBq/kg)	58.34	6.03	0.47	0.88	1.79	0.22	0.37

[1]J.L. Ma, Q. Yue, S. Lin, et al., Study on cosmogenic activation in germanium detectors for future tonne-scale CDEX experiment. Sci. China: Phys. Mech. Astron. 62, 1-10(2019). 23

### 3马林杯样品本底能谱

() 「「「 新大学 Tsinghua University



<sup>60-2700</sup>keV本底计数率

本底来源	counts rate kg <sup>-1</sup> day <sup>-1</sup>
total	16.65
Ge宇生核素	4.79
Cu shield	7.77
holder	2.22
Cu Cryostat	1.64
Rn-222	0.12
FET	0.12

宇生本底不可忽略 主要本底来自铜材料的铜屏蔽、低温恒温器、支架 FET和氡本底不可忽略

1	蒹	火	1 A
Tsing	hua l	Unive	<b>s</b> rsity

Sample shape	Mass(kg)	<sup>222</sup> Rn concentrations (Bq/m <sup>3</sup> )	$\frac{\text{MDA} (\mu \text{Bq/kg})}{^{214}\text{Bi}(609\text{keV})}$	<sup>212</sup> Pb(238keV)	<sup>40</sup> K (1460keV)
		0.1	32.8	28.8	70.9
Marinelli beaker	118.29	1	37.7	29.9	71.7
		10	65.9	38.0	78.1
		0.1	94.1	74,8	172.6
Cylinder	67.66	1	101.5	76.1	173.8
		10	154.0	87.7	185.4

对于具有118.3 kg质量的铜样品和100天测量时间,<sup>214</sup>Bi的MDA为32.8µBq/kg,<sup>212</sup>Pb 的MDA为28.8µBq/kg。通过使用10µBq/kg活度的高纯无氧铜,本底计数率可以降低 到小于10cpkd,马里内利烧杯形状样品的MDA可以降低到约10µBq/kg。

### 3 Argus模拟总结

Geant4蒙卡模拟 cern root数据处理 Tsinghua





<mark>探测效率</mark>:改变样品形状、大小、材料和 几何结构

本底水平:考虑锗宇生核素、探测器内元 件、铅铜屏蔽、氡本底等

分项包括宇生核素、FET尺寸屏蔽、冷指 缝、岩石本底、Ge死层、冷指下杂物等

样品	100天	<sup>238</sup> U	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K
	MDA(µBq/kg)	(609keV)	(238keV)	(1460keV)
<b>马林杯</b> 118.29kg Cu	5个探测器 冷却3年 氡浓度0.1Bq/m <sup>3</sup>	32.8	28.8	70.9

**达到系统指标:** MDA小于100.0 µBq/kg





### 4 总结与展望

- ())清華大学 Tsinghua University
- (1) 使用GeTHU-IV<mark>能谱分解</mark>的方法检验本底模型,为极低本底谱仪模拟做参考,在此 基础上完成mBq/kg量级谱仪等的模拟优化
- (2) 提出<mark>多探头谱仪ARGUS的</mark>MDA计算流程,模拟优化,达到MDA小于100µBq/kg水
- 平,证实ARGUS可行性,为生产加工提出具体要求
  - (3) 后续建成ARGUS目标,<mark>本底和MDA达到世界先进水平</mark>,优于同类探测器

### 下一步工作

- (1) 设计重新搭建GeTHU-IV,最终目标实现氡由 $20Bq/m^3$ 降低至 $0.1Bq/m^3$ 的水平
- (2) 建成ARGUS,设计完成测试实验



请批评指正!

